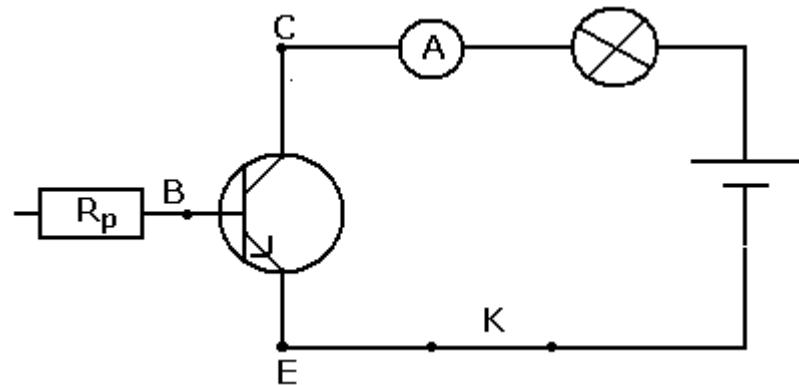


تمارين حول الترانزستور

تمرين 1

يتكون تركيب الشكل 1 من ترانزستور NPN ، ومصباح وعمود كهربائي .

1 – إذا كان لدينا عمود آخر وأسلاك التوصيل .



1 – أتمم التركيب لكي يصبح الترانزستور مارا باستعمال العمود وأسلاك التوصيل .

1 – 2 – مثل بأسمهم منحى التيار الكهربائية المارة عبر الرانزستور ، وأعط اسم كل منها .

1 – 3 – ما دور الموصل الأومي ذي المقاومة R_p ؟

2 – إذا كان لدينا سلك موصل واحد فقط .

2 – 1 أتمم التركيب من جديد لكي يصبح الترانزستور مارا .

2 – 2 ماذا يمكن أن يحصل للترانزستور إذا أصبحت شدة تيار القاعدة كبيرة جدا ؟

تمرين 2

نعتبر التركيب الممثل في الشكل جانبي ، حيث يتتوفر الترانزستور على معامل التضخيم الساكن : $\beta=100$ و $U_{BE}=0,7V$ و $U_{AC}=3V$.

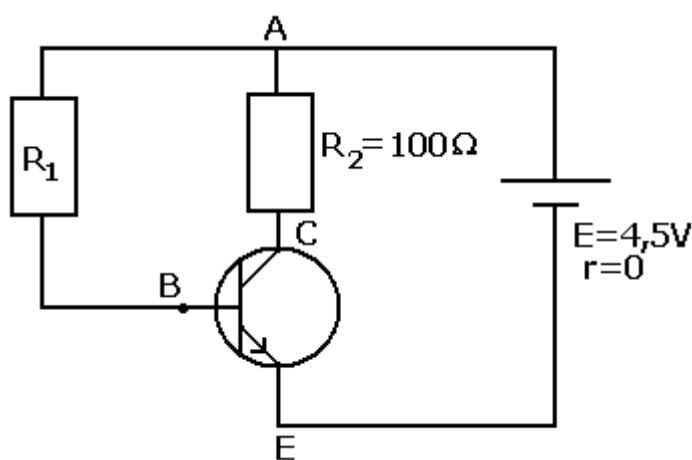
علما أن الترانزستور يشتغل في النظام الخططي أحسب :

1 – شدة تيار المجمع I_C .

2 – قيمة المقاومة R_1 .

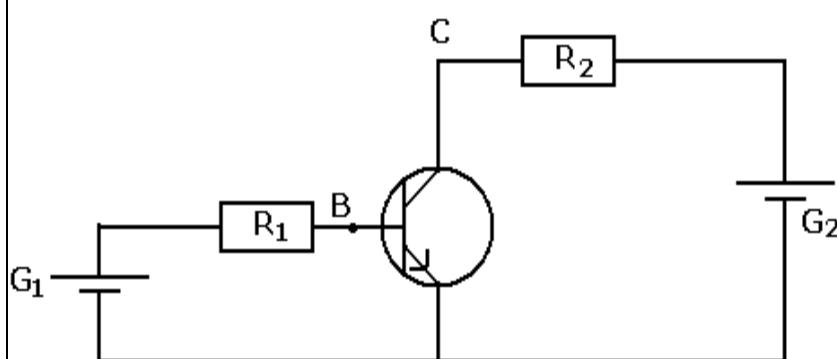
تمرين 3

ننجز التركيب الممثل في الشكل 3 والمكون



من مولدين كهربائيين G_1 قوته الكهرمحركة $E_1=1,5V$ و مقاومته مهملة ، و G_2 قوته الكهرمحركة $E_2=6V$ و مقاومته مهملة . وموصلين أوميين R_1 و R_2 .

يشتغل الرانزستور في النظام الخططي ومعامل التضخيم للتيار هو $\beta=80$. نعطي $I_B=2,5mA$ و $U_{BE}=0,6V$. عين قيمة كل من R_1 و R_2 .



الشكل 3

تمرين 4

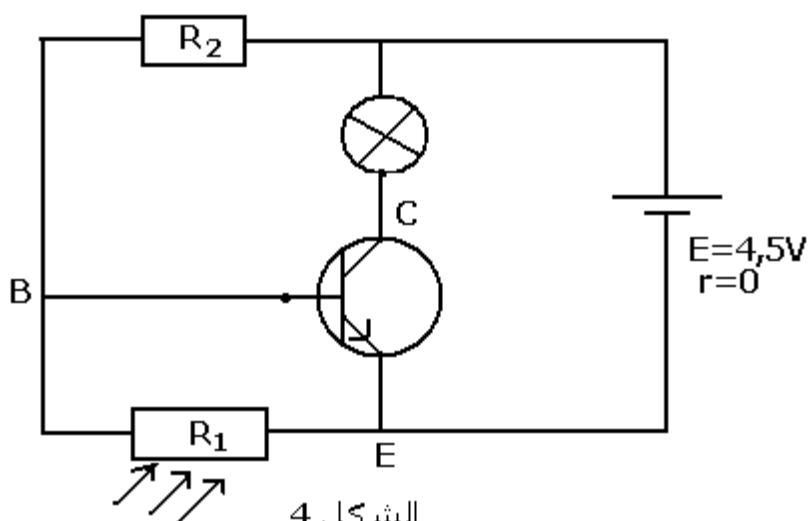
نجز التركيب في الشكل 4 والمكون من ترانزستور NPN معامل تصخيمه $\beta=200$ ومقاومة ضوئية R_1 تتغير مقاومتها من $1M\Omega$ في الظلام إلى 500Ω في الضوء الباهر ، ومصباح يتطلب اشتغاله نيارا كهربائيا شدته $I_F=200mA$. في حالة الاشتغال العادي للترانزستور $U_{BE}=0,7V$.

1 – أعط اسماء لكل من المقاومة الضوئية والمصباح حسب دور كل منهما في التركيب .

2 – أوجد قيمة R_2 لكي يكون الترانزستور متوقفا عندما توجد المقاومة الضوئية في الضوء الباهر

3 – بين أن المصباح يضيء عندما تكون المقاومة الضوئية في الظلام .

4 – ما الاستعمالات التي يمكن أن يستغل فيها مثل هذا التركيب ؟



تمرين 5

نعتبر السلسلة الإلكترونية الممثلة في الشكل أسفله والمكونة من : مولد كهربائي G قوته الكهرومagnetة $E=6V$ و مقاومته الداخلية مهملة .

ترانزستور معامل تصخيمه الساكن $\beta=80$ و $U_{BE}=0,6V$ عندما يشتعل في النظام الخطي .

ثنائي القطب D_1 و D_2 صمام ثبائي متالك كهربائيا مؤمثل ويحمل الإشارة $U_s=1,8V$.

موصلين أو مبيين مقاومتها $R_1=100\Omega$ و $R_2=5k\Omega$.

1 – حدد طبيعة D_1 ودور كل من الموصلين الأوبيين R_1 و R_2 في هذا التركيب .

2 – عند درجات الحرارة المنخفضة $t < 20^\circ C$ تكون شدة تيار القاعدة ($I_B=0$) . حدد في هذه الحالة نظام اشتغال الترانزستور على جوابك .

3 – عند درجة الحرارة $t=45^\circ C$ تكون شدة تيار القاعدة $I_b=0,2mA$ وبهيء ثبائي القطب D_2 .

3 – 1 أحسب I_C شدة تيار المجمع وبين أن قيمة شدة التيار الباعث هي $I_E=16,2mA$.

3 – 2 أوجد قيمة المقاومة R_T لثبائي القطب D_1 عند درجة الحرارة $t=45^\circ C$.

4 – اقترح تطبيقا عمليا لهذه السلسلة الإلكترونية وحدد مجموعاتها الوظيفية .

تمرين 6 :

يتكون التركيب المبين في الشكل جانبه من :

– G مولد قوته الكهرومagnetica E₁ و مقاومته الداخلية مهمملة .

– ترانزستور BD131

– مصباح الإشعار L يتطلب اشتغاله تيارا كهربائيا شدته I_{C0}=0,2A .

موصل أومي خاص بوقاية التركيب مقاومته R₁=5.10³Ω .

مقاومة ضوئية تتغير مقاومتها R من 10⁶Ω في الظلام إلى 150Ω في الضوء الباهر .

1 – ما نوع الترانزستور المستعمل في التركيب .

2 – حدد في التركيب : اللاقط والجهاز الإلكتروني وجهاز الإستعمال .

3 – توجد المقاومة الضوئية في الظلام ، ما هي الحالة التي يوجد عليها الترانزستور ؟ علل جوابك بدون حساب

4 – نصيء المقاومة الضوئية ، فيمر في دارة القاعدة تيار كهربائي شدته I_B ونعتبر الترانزستور يشتغل في النظام الخطى .

لتعيين قيمة التوتر U_{AM} بين مربطي المقاومة الضوئية المستعمل راسم التذبذب .

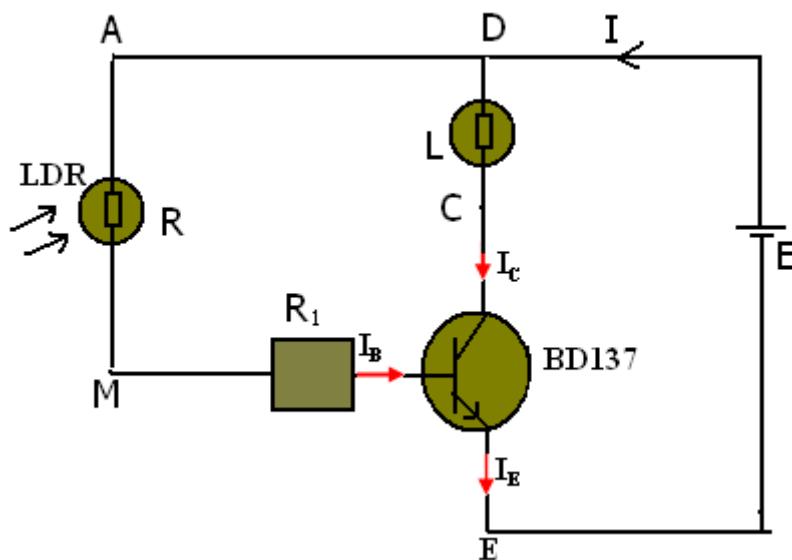
4 – 1 علما أن U_{AM}>0 بين كيفية ربط النقطتين A و M بهيكل كاشف التذبذب وبمدخله Y .

4 – 2 علما أن قيمة التوتر U_{AM}=0,4V وأن البقعة الضوئية تتقل على شاشة راسم التذبذب نحو الأعلى بمسافة d=2cm ، حدد الحساسية الرأسية المستعملة .

5 – علما أن الترانزستور المستعمل له تضخيم ساكن للتيار $\beta=100$ ، هل سيشتغل مصباح الإشعار أم لا ؟ علل جوابك . نعطي I_B=1mA .

6 – بتطبيق قانون العقد ، أوجد الشدة I للتيار الذي يمر في المولد .

7 – بتطبيق قانون إضافية التوترات عين قيمة القوة الكهرومagnetica E₁ للعمود علما أن U_{BE}=0,6V



التمرين 7 :

نعتبر التركيب المبين جانبه حيث الترانزستور تضخيم ساكن للتيار $\beta=100$ وبواسطة فولطметр إلكتروني نقيس التوترات التالية : $U_{AC}=8V$ و $U_{BE}=0,7V$ و $U_{CE}=6V$. علماً أن الترانزستور يشتغل في النظام الخطي .

1 – أحسب قيمة شدة التيار المجمع I_C .

2 – أحسب قيمة المقاومة R_1

3 – أحسب قيمة شدة تيار الباعث I_E واستنتج قيمة المقاومة R_3 .

